# Caracteristici statice ale tranzistorului cu jonctiune bipolara

Blidaru Tudor-Stefan, grupa 262

#### I. Introducere

Configurația cu emitor comun (CEC) și configurația cu bază comună (CBC) se bazează pe faptul că Baza, respectiv Emitorul, sunt conectate la masa comună a circuitului. Masa comună reprezintă conexiunea dintre una dintre ieșirile unui rețele cu patru terminale și o ieșire de tip jack. Dacă tranzistorul este de tip PNP, săgeata emitorului trebuie să indice direcția inversă, de exemplu, în interiorul tranzistorului.

Folosind patru variabile pentru caracterizarea operației cvadripolului (două la intrare și două la ieșire), putem reprezenta caracteristicile statice ale tranzistorului alegând două variabile independente și reprezentând celelalte două variabile dependente în funcție de acestea. De exemplu, putem selecta IC și VCE ca variabile independente pentru configurarea cu emitor comun (CEC). Pentru a funcționa în regiunea activă a tranzistorului, este necesar să aplicăm o tensiune de polarizare directă pe joncțiunea emitorului si o tensiune de polarizare inversă pe jonctiunea colectorului.

### 1. Montaj experimental:

- Între bornele 1 și 2, se conectează un microampermetru pentru a măsura curentul de bază IB
- Între bornele 2 și 3, se conectează un milivoltmetru pentru a măsura tensiunea de bază VR
- Între bornele 4 și 5, se conectează un ampermetru pentru a măsura curentul de colector IC.

#### 2. Scopul:

- Această configurație este utilizată pentru măsurarea caracteristicilor de intrare (curentul IB în funcție de tensiunea VB) și de ieșire (curentul IC în funcție de VCE).
- Se setează VCE la valori constante pentru caracteristicile de intrare.
- Pentru caracteristicile de ieșire, IC este măsurat pentru valori diferite ale IB.

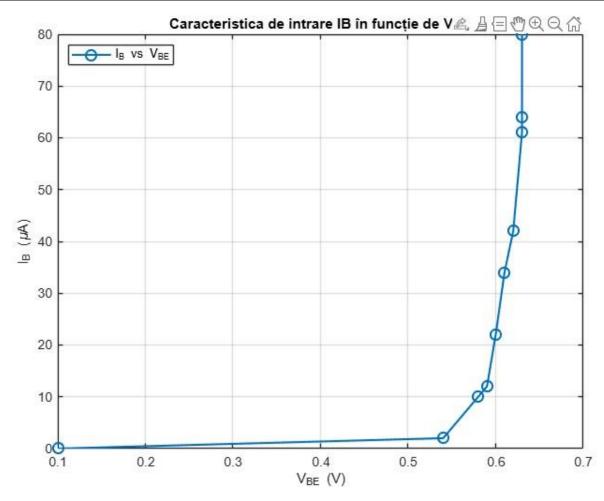
#### 3. Formula:

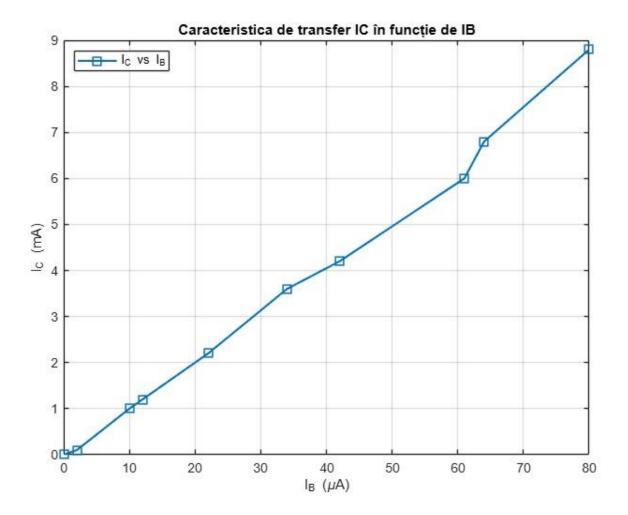
Utilizând relația IC $\approx$  $\beta$ I, se poate calcula din nou câștigul de curent  $\beta$ , obținut din caracteristicile de ieșire.

# **Date Experimenale**

| NR | IB(uA) | IE(mA) | VBE(V) |
|----|--------|--------|--------|
| 1  | 0      | 0      | 0,1    |
| 2  | 2      | 0,1    | 0,54   |
| 3  | 10     | 1,0    | 0,58   |
| 4  | 12     | 1,2    | 0,59   |

| 5  | 22 | 2,2 | 0,6  |
|----|----|-----|------|
| 6  | 34 | 3,6 | 0,61 |
| 7  | 42 | 4,2 | 0,62 |
| 8  | 61 | 6,0 | 0,63 |
| 9  | 64 | 6,8 | 0,63 |
| 10 | 80 | 8,8 | 0,63 |



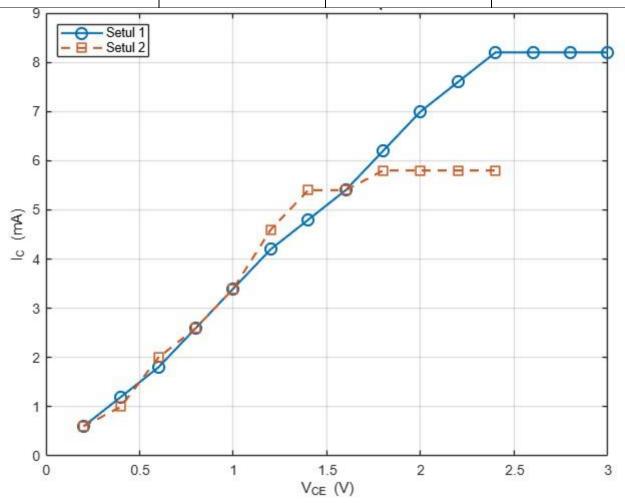


| NR | IC(mA) | VCV(mV) | VCE(V) |
|----|--------|---------|--------|
| 1  | 0,6    | 30      | 0,2    |
| 2  | 1      | 39      | 0,4    |

| 3           | 2      | 62      | 0,6    |
|-------------|--------|---------|--------|
| IC = 80  uA |        |         |        |
| NR          | IC(mA) | VCV(mV) | VCE(V) |
| 1           | 0,6    | 25      | 0,2    |
| 2           | 1,2    | 39      | 0,4    |
| 3           | 1,8    | 51      | 0,6    |
| 4           | 2,6    | 61      | 0,8    |
| 5           | 3,4    | 71      | 1,0    |
| 6           | 4,2    | 81      | 1,2    |
| 7           | 4,8    | 91      | 1,4    |
| 8           | 5,4    | 101     | 1,6    |
| 9           | 6,2    | 114     | 1,8    |
| 10          | 7      | 130     | 2      |
| 11          | 7,6    | 150     | 2,2    |
| 12          | 8,2    | 220     | 2,4    |
| 13          | 8,2    | 400     | 2,6    |
| 14          | 8,2    | 600     | 2,8    |
| 15          | 8,2    | 800     | 3      |
| IC (0 )     |        |         |        |

IC = 60 uA

| 4  | 2,6 | 75  | 0,8 |
|----|-----|-----|-----|
| 5  | 3,4 | 87  | 1,0 |
| 6  | 4,6 | 104 | 1,2 |
| 7  | 5,4 | 125 | 1,4 |
| 8  | 5,4 | 150 | 1,6 |
| 9  | 5,8 | 276 | 1,8 |
| 10 | 5,8 | 460 | 2   |
| 11 | 5,8 | 640 | 2,2 |
| 12 | 5,8 | 860 | 2,4 |



#### Concluzie

În cadrul acestei lucrări, am analizat caracteristicile tranzistorului bipolar utilizând configurația cu emitor comun (CEC). Studiul caracteristicilor de intrare, transfer și ieșire a permis observarea comportamentului tranzistorului în diferite regimuri de funcționare, evidențiind următoarele aspecte principale:

# 1. Caracteristica de intrare (IB în funcție de VBE):

- Curentul de bază IBI\_BIB crește exponențial cu tensiunea de polarizare VBE, reflectând natura jonctiunii semiconductoare de tip PN.
- Pragul de tensiune pentru activarea tranzistorului a fost identificat în jurul valorii de VBE≈0.6 V.

# 2. Caracteristica de transfer (IC în funcție de IB):

• S-a observat o relație aproape liniară între ICI și IB, ceea ce confirmă faptul că tranzistorul acționează ca un amplificator de curent, cu un factor de amplificare β stabil.

# 3. Caracteristica de ieșire (IC în funcție de VCE):

- Curentul colectorului IC crește cu VCE în regim de saturație, dar devine aproape constant în regimul activ, evidențiind stabilitatea curentului colectorului pentru valori mari ale tensiunii VCE.
- În regimul activ, curentul colectorului este controlat în principal de curentul de bază, iar variațiile lui VCE au un impact redus.

Această analiză confirmă că tranzistorul în configurația cu emitor comun este eficient pentru amplificarea semnalelor, având caracteristici bine definite de intrare, transfer și ieșire. Totodată, experimentele au subliniat importanța polarizării corecte a joncțiunilor pentru obținerea unei funcționări optime. Aceste rezultate pot fi utilizate în proiectarea de circuite electronice analogice, cum ar fi amplificatoarele sau oscilatoarele